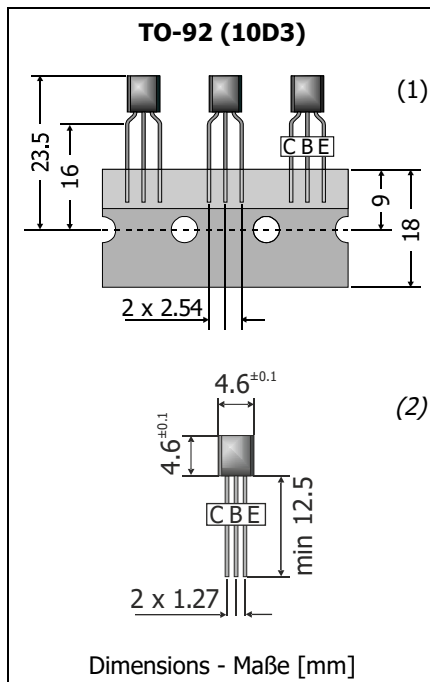


BC327 ... BC328
General Purpose PNP Transistors
Universal-PNP-Transistoren

$I_C = -800 \text{ mA}$
 $h_{FE} \sim 160/250/400$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

$V_{CE0} = -25 \dots -45 \text{ V}$
 $P_{tot} = 625 \text{ mW}$

Version 2018-02-02

**Typical Applications**

Signal processing,
 Switching, Amplification
 Commercial grade ¹⁾

Features

General Purpose
 Three current gain groups
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

- (1) Taped in ammo pack
 (Raster 2.54)
 (2) On request: in bulk
 (Raster 1.27, suffix "BK")

Weight approx.

Case material

Solder & assembly conditions



4000

5000

0.18 g

UL 94V-0

260°C/10s

MSL N/A

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung,
 Schalten, Verstärken
 Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Universell anwendbar
 Drei Stromverstärkungsklassen
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

- (1) Gegurtet in Ammo-Pack
 (Raster 2.54)
 (2) Auf Anfrage: Schüttgut
 (Raster 1.27, Suffix "BK")

Gewicht ca.

Gehäusematerial

Löt- und Einbaubedingungen

Current gain groups Stromverstärkungsgruppen		Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren
BC327-16 BC327-25 BC327-40	BC328-16 BC328-25 BC328-40	BC337 ... BC338

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

			BC327	BC328
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	E-B short	- V_{CES}	50 V	30 V
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V_{CEO}	45 V	25 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- V_{EBO}	5 V	
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	625 mW ³⁾	
Collector current – Kollektorstrom	DC	- I_C	800 mA	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- I_{CM}	1 A	
Base current – Basisstrom		- I_B	100 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-55...+150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	-55...+150°C	

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2 $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben

3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
 Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

$T_j = 25^{\circ}\text{C}$				Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾						
- $V_{CE} = 1\text{ V}$	- $I_C = 100\text{ mA}$	Group -16	h_{FE}	100	160	250
		Group -25		160	250	400
		Group -40		250	400	630
	- $I_C = 300\text{ mA}$	Group -16	h_{FE}	60	130	–
		Group -25		100	200	–
		Group -40		170	320	–
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. ¹⁾						
- $I_C = 500\text{ mA}$ - $I_B = 50\text{ mA}$			- V_{CESat}	–	–	0.7 V
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹⁾						
- $V_{CE} = 1\text{ V}$ - $I_C = 300\text{ mA}$			- V_{BE}	–	–	1.2 V
Collector-Emitter cutoff current – Kollektor-Emitter-Reststrom						
- $V_{CE} = 45\text{ V}$	B-E short	BC327	- I_{CES}	–	2 nA	100 nA
- $V_{CE} = 25\text{ V}$		BC328				
- $V_{CE} = 45\text{ V}$	B-E short	BC327	- I_{CES}	–	–	10 μA
- $V_{CE} = 25\text{ V}$		$T_j = 125^{\circ}\text{C}$ BC328				
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz						
- $V_{CE} = 5\text{ V}$, - $I_C = 10\text{ mA}$, $f = 50\text{ MHz}$			f_T	–	100 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität						
- $V_{CB} = 10\text{ V}$, $I_E = i_e = 0$, $f = 1\text{ MHz}$			C_{CBO}	–	12 pF	–
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung			R_{thA}	< 200 K/W ²⁾		

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)

Haftungsschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden